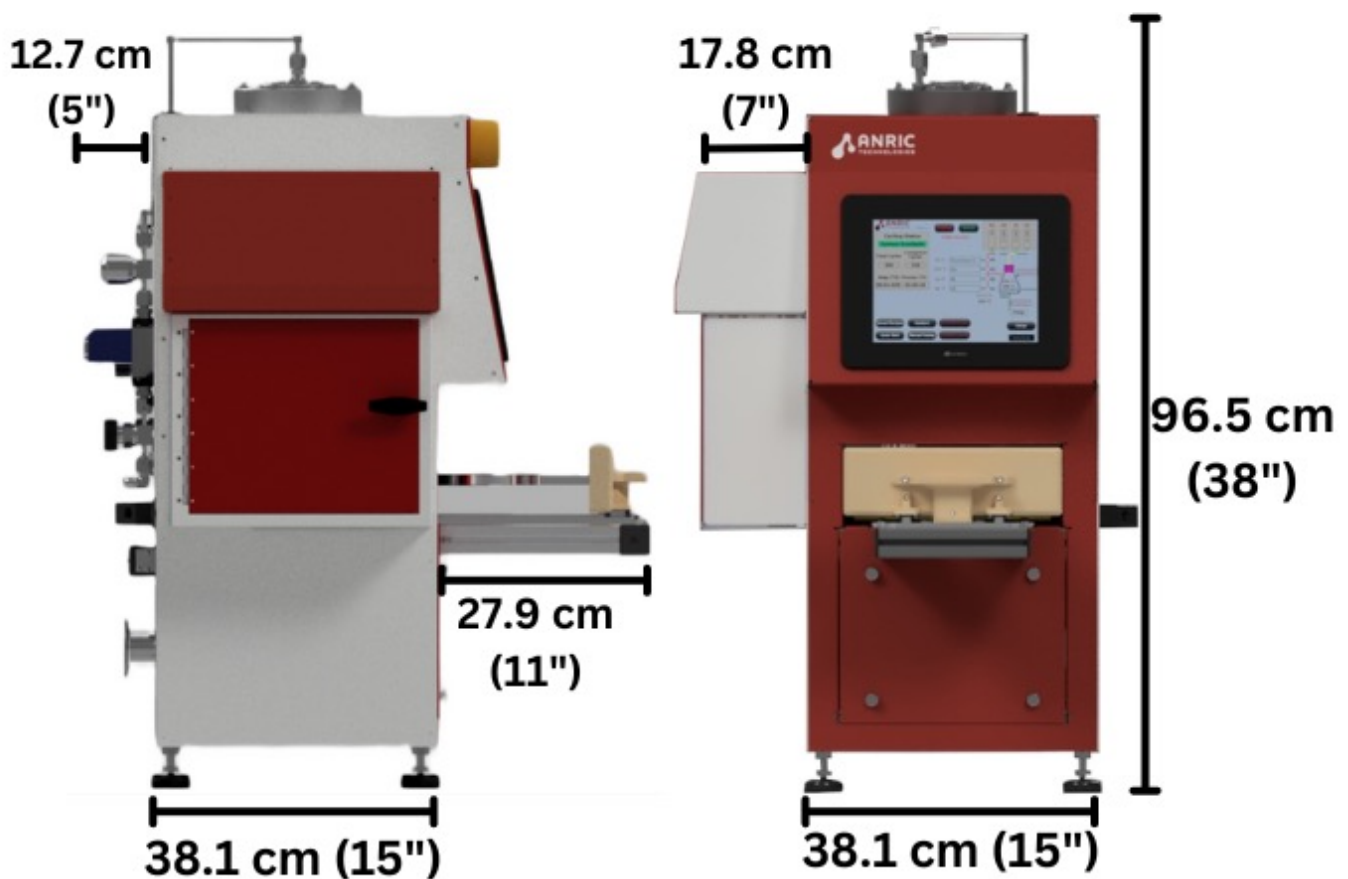
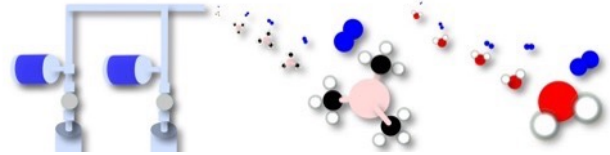


Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition プラズマ式原子層堆積装置



Model: AT-650P (6インチ)

メーカー: Anric Technologies社

プラズマ機能のない熱式ALDも可能(AT-650T)

半導体プロセスの研究用に開発。ICP or ホローカソード機構を備えた、小型ながら本格的なプラズマ式原子層堆積装置。

AT-400/410から継承した直感的ユーザーインターフェース。

Anric Technologies社製

項目	仕様
設置面積	幅: 381 (559) x 奥行: 381 x 高さ: 965mm
有機金属プリカーサー	標準3系統 (Max. 4ライン)
有機金属プリカーサー加熱温度	Max. 185°C
酸化還元プリカーサー	標準2系統 (Max. 4ガスライン)
プラズマ生成方式	ICP (誘電結合プラズマ)方式 13.56MHz ホローカソード方式
基板(試料)最大サイズ	○6インチ (150mm)
基板加熱温度	Max. 400°C

その他オプション(お問合せ下さい。)

- カスタマイズ承ります。
- ロードロック機構
- 特殊基板ステージの設計変更可能です。
- N2アシストラインの追加(低蒸気圧プリカーサー用)



輸入総代理店:

ALDジャパン株式会社

〒183-0056 東京都府中市寿町1-3-10-401

Phone: **042-360-3152** Fax: 042-633-0916

E-mail: sales@aldjapan.com

